

# 表目錄

## 第一章

表1-1 2004 International Technology Roadmap for Semiconductor。

表1-2 高介電常數材料作為閘極介電層所需要的要件和需求。

表1-3 MOCVD、PVD、ALCVD 三種沉積方法的優缺點比較。

## 第二章

表2-1 實驗條件。

## 第五章

表5-1 SC1 前處理和 RTO 前處理二氧化鋁場效電晶體的特性。

## 第六章

表6-1 n 型和 p 型金氧半場效電晶體在正偏壓或負偏壓下，發生界面層(interfacial layer)崩潰或本體崩潰(bulk breakdown)時，其源極電流和井電流變化量之間的關係。

